Sm(Fe, Co)₁₂薄膜の Co 添加による磁気特性の変化

齋藤豪太、土井正晶、嶋敏之 (東北学院大)

Effect of Co-substitution for Sm(Fe, Co)₁₂ thin films and their magnetic properties G. Saito, M. Doi and T. Shima
(Tohoku Gakuin Univ.)

はじめに

Nd₂Fe₁₄B 相を主相とする Nd-Fe-B 焼結磁石は、現行の商業用永久磁石の中で最も優れた磁気特性を有しており、様々な工業製品に広く応用されている。一方で、1984 年に Nd-Fe-B 磁石が発明されて以来、その磁気特性を超える新規磁性材料は発見されておらず、そのような新規材料の開発が強く望まれている。現在期待されている磁性材料のうち、特に ThMn₁₂型の結晶構造を有する RFe₁₂ (R: 希土類元素) 系磁石は、R-Fe 系の化合物相の中でも最大の Fe 濃度を有していることから、Nd-Fe-B 磁石を超える優れた磁気特性を発現できるとされている。近年、SmFe₁₂ 薄膜に対して Fe の一部を Co に置換した Sm (Fe, Co)₁₂ 薄膜において、不安定とされる ThMn₁₂型結晶構造の安定化と、Nd-Fe-B 磁石を超える一軸磁気異方性と自発磁化が報告され注目を浴びている ¹⁾。しかしながら、SmFe₁₂ 薄膜への Co 添加による結晶構造や磁気特性への影響は十分に理解されておらず、その調査が強く要求されている。そこで本研究では、SmFe₁₂ 薄膜及びそれに Co を置換した Sm (Fe, Co)₁₂ 薄膜を作製し、その結晶構造及び磁気特性について詳細に調べた。

実験方法

薄膜試料は超高真空多元スパッタ装置を用いて、MgO (100) 単結晶基板上に作製した。バッファー層として V を 10 nm 成膜し、700 °C に加熱して 30 分間エピタキシャル成長させた。その後、基板温度を $200 \sim 400$ °C まで変化させ、 $SmFe_{12}$ 層を 50 nm 成膜した。なお、 $SmFe_{12}$ 層の成膜には Sm と Fe のターゲットを用い、同時成膜によって作製した $SmFe_{12}$ 合金膜の試料と、Sm 層を t_{Sm} nm、Fe 層を $(1-t_{Sm})$ nm として 50 回交互成膜した $SmFe_{12}$ 積層膜の試料をそれぞれ作製した。その後、酸化保護膜として V を 10 nm 成膜した。作製した試料は、結晶構造を X 線回折装置 (XRD)、磁気特性を超伝導量子干渉磁束計 (SQUID) を用いて評価を行った。

実験結果

基板温度を変化させた $SmFe_{12}$ 積層膜を作製し、構造及び磁気特性の評価を行った。基板温度の上昇に従い $SmFe_{12}$ 相からのピーク強度が増加し、 $T_S=300$ $^{\circ}$ C において $SmFe_{12}$ 相からのピークが明瞭に確認された。基板温度を更に上昇させることにより $SmFe_{12}$ 相からのピーク強度が減少したことから、 $SmFe_{12}$ 積層膜においては $T_S=300$ $^{\circ}$ C が最適であるものと考えられる。次に、 $T_S=300$ $^{\circ}$ C に固定し、 $SmFe_{12}$ 積層膜の Sm 膜厚 t_{Sm} を変化させた試料の XRD $パターンを Fig. 1 に示す。化学両論組成となる <math>t_{Sm}=0.08$ nm の試料では、 $T_S=10$ nm のよりのピークが確認された。 $T_S=10$ nm の影響では、 $T_S=10$ nm のピークは減少し、 $T_S=10$ nm の影響では、 $T_S=10$ nm のピークは減少し、 $T_S=10$ nm の影響では $T_S=10$ nm の別判明した。講演時には $T_S=10$ nm のピーク強度が増大することが判明した。講演時には $T_S=10$ nm $T_S=10$ mm T_S

参考文献

1) Y. Hirayama, Y.K. Takahashi, S. Hirosawa and K. Hono., *Scr. Mater.*, **138** (2017) 62-65.

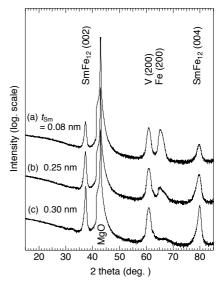


Fig. 1. X-ray diffraction patterns for SmFe₁₂ [Sm $(t_{\rm Sm}$ nm)/ Fe $(1-t_{\rm Sm}$ nm)]₅₀ stacking thin films with different Sm layer thickness. (a) $t_{\rm Sm} = 0.08$ nm, (b) 0.25 nm and (c) 0.30 nm.